

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد

عنوان:

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرسانای رقیق شده ترکیب $Zn_{1-x}Mn_xO$

استاد راهنما:

دکتر منوچهر بابائی پور

استاد مشاور:

دکتر فریدون سموات

پژوهشگر:

فریبا ایمانیان

آبان ماه ۱۳۹۰

همه امتیازهای این پایان نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب پایان نامه در مجلات، کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها، باید نام دانشگاه بوعلی (یا استاد یا اساتید راهنمای پایان نامه) و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.



دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی

عنوان:

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیم رسانای رقیق شده ترکیب $Zn_{1-x}Mn_xO$.

نام نویسنده: فریبا ایمانیان

نام استاد راهنما: دکتر منوچهر بابائی پور

نام استاد مشاور: دکتر فربیدون سموات

دانشکده : علوم	گروه آموزشی: فیزیک
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد	گرایش تحصیلی: حالت جامد
تعداد صفحات: ۱۲۲	تاریخ دفاع: ۱۳۹۰/۸/۲۲

چکیده:

یکی از مسائل مهم در زمینه اسپینترونیک، تزریق جریان پلاریزه اسپینی از یک فلز فرومغناطیس به یک نیمرسانا است. در سالهای اخیر فرومغناطیس‌های نیمه‌فلز به دلیل توانایی بالا در تولید جریان قطبیده اسپینی مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. نیمه‌فلزات موادی هستند که برای یک نوع اسپین رفتار فلزی و برای نوع دیگر رفتار نیمرسانایی از خود نشان می‌دهند و لذا این مواد در سطح فرمی خود دارای قطبش ۱۰۰ درصدی اسپینی هستند.

ما نیز در این رساله قصد داریم که با بررسی نیمرسانای ZnO و وارد کردن فلز واسطه مغناطیسی منگنز به عنوان ناخالصی، به مطالعه خواص الکترونی و مغناطیسی این ترکیب پردازیم.

در فصل اول تئوری تابعی چگالی مورد بورسی قرار گرفت. در فصل دوم به مطالعه خواص نیمرسانائی و مغناطیسی پرداخته شد. در فصل سوم خواص ساختاری و مغناطیسی سه ساختار انبوه ZnO مورد بررسی قرار گرفت. برای اینکار ابتدا ابریاخته مناسب تولید و سپس آلاتیden با درصدهای مختلف به عنوان ناخالصی مغناطیسی مورد بررسی قرار دادیم. سپس خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک خالص و آلاتیde شده با منگنز را برای هر سه ساختار اکسیدروی مورد مطالعه قراردادیم.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: تئوری تابعی چگالی
۲	۱-۱ روش‌های محاسبه انرژی بلور
۴	۲-۱ تقریب بورن-اپنهایمر
۶	۳-۱ تقریب هارتی
۷	۴-۱ تقریب هارتی-فوک
۷	۵-۱ چگالی الکترونی
۸	۶-۱ نظریه توماس-فرمی
۱۰	۷-۱ نظریه توماس-فرمی-دیراک
۱۱	۸-۱ روش تابعی چگالی
۱۲	۹-۱-۱ معادلات کوهن-شم
۱۶	۹-۱ روش‌های حل انرژی تبادلی-همبستگی
۱۶	۱۰-۱ تقریب چگالی موضعی
۱۷	۱۱-۱ شیب تعمیم یافته

۱۸.....	LDA + C تقریب ۳-۹-۱
۱۸.....	LDA + U تقریب ۴-۹-۱
۱۹.....	۱۰-۱ روش‌های حل معادلات کوهن-شم
۱۹.....	۱-۱۰-۱ روش امواج تخت بهبودیافته
۲۲.....	۲-۱۰-۱ روش امواج تخت بهبودیافته خطی
۲۵.....	APW+Lo روش ۳-۱۰-۱
۲۶.....	APW + LO + lo روش ۴-۱۰-۱
۲۷.....	FP + LAPW روش ۵-۱۰-۱
۲۸.....	فصل دوم: نیمرسانا و مغناطیس
۲۹.....	مقدمه
۳۱.....	۱-۲ انواع نیمرسانا
۳۱.....	۱-۱-۲ نیمرساناهای ذاتی
۳۲.....	۲-۱-۲ نیمرساناهای غیر ذاتی
۳۳.....	۳-۱-۲ پایه علمی نیمرسانای نوع n
۳۵.....	۴-۱-۲ پایه علمی نیمرسانای نوع p
۳۶.....	۲-۲ آمار نیمرسانا
۳۶.....	۱-۲-۲ ناحیه ذاتی
۳۷.....	۲-۲-۲ ناحیه غیرذاتی

۳۹.....	۳-۲ گاف نواری
۴۰.....	۱-۳-۲ وابستگی گاف نواری به دما
۴۰.....	۲-۳-۲ انواع گاف نواری
۴۱.....	۴-۲ حامل‌های بار در نیمرساناهای
۴۴.....	۵-۲ سطوح فرمی
۴۵.....	۶-۲ باند انرژی
۴۵.....	۷-۲ مدل الکترون آزاد
۴۶.....	۸-۲ نوار انرژی نیمرساناهای
۴۷.....	۹-۲ فلزات واسط
۴۷.....	۱۰-۲ نیمرساناهای اکسیدی
۴۸.....	۱۱-۲ مغناطیس
۴۸.....	۱-۱۱-۲ رفتار مغناطیسی مواد
۵۰.....	۱۲-۲ تقسیم‌بندی مواد مغناطیسی
۵۰.....	۱-۱۲-۲ مواد پارامغناطیس
۵۱.....	۱-۱-۱۲-۲ رفتار پارامغناطیس مواد
۵۲.....	۲-۱۲-۲ مواد دیامغناطیس
۵۲.....	۱-۲-۱۲-۲ رفتار دیامغناطیس مواد

۵۲.....	۳-۱۲-۲ مواد فرومغناطیس
۵۴.....	۱-۳-۱۲-۲ مواد فرومغناطیس نرم
۵۴.....	۲-۳-۱۲-۲ مواد فرومغناطیس سخت
۵۵.....	۱۳-۲ پادفرومغناطیس
۵۶.....	۱۴-۲ فریمغناطیس
۵۶.....	۱۵-۲ تقسیم بندی مواد مغناطیسی از نظر دمایی
۵۶.....	۱-۱۵-۲ فرومغناطیس
۵۷.....	۲-۱۵-۲ فری مغناطیس
۵۷.....	۳-۱۵-۲ پادفرومغناطیس
۵۸.....	فصل سوم: خواص ساختاری والکترونی و مغناطیسی اکسیدروی
۵۹.....	مقدمه
۶۱.....	۱-۳ معرفی اکسیدروی
۶۶.....	۲-۳ روش انجام محاسبات
۶۶.....	۳-۳ بهینه‌سازی پارامترهای محاسباتی
۶۶.....	۱-۳-۳ بهینه کردن تعداد RKmax
۶۸.....	Kpoint ۲-۳-۳
۷۰	۳-۳-۳ بهینه‌سازی پارامترهای شبکه

٧٣.....	٣-٤ خواص الکترونی و مغناطیسی اکسیدروی
٧٣.....	١-٤-٣ خواص الکترونی و مغناطیسی ابرسلول اکسیدروی خالص
٧٥.....	٣-٥ خواص الکترونی و مغناطیسی ابرسلول اکسیدروی آلائیده شده با Mn
٨٢.....	٣-٦ خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی لایه نازک
٨٢.....	١-٦-٣ خواص ساختاری لایه نازک
٨٣.....	٣-٦-٣ خواص الکترونی لایه نازک
٩٠.....	نتیجه‌گیری
٩١.....	پیشنهادات
٩٢.....	پیوست
١١٩.....	مراجع

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحة
جدول ۱-۳ تغییرات انرژی(ev) بر حسب RKmax	۶۷
جدول ۲-۳ تغییرات انرژی(ev) بر حسب Kpoint	۶۹
جدول ۳-۳ مقادیر ثابت‌های شبکه بدست آمده و مقایسه با داده‌های تجربی	۷۰
جدول ۳-۴ مقادیر ثابت‌های شبکه بدست آمده و مقایسه با داده‌های تجربی	۷۲
جدول ۳-۵ مقادیر ثابت‌های شبکه بدست آمده و مقایسه با داده‌های تجربی	۷۳
جدول ۳-۶ قطبش و شکافت تبادلی در صدھای مختلف منگنز	۸۱
جدول ۳-۷ مقادیر FERMI,MMTOT,MMI	۸۲
جدول ۳-۸ مقادیر Energy,Fermi,MMTOT برای سه ساختار فیلم نازک اکسیدروی	۸۹
جدول ۳-۹ مقادیر Energy, Fermi, MMTOT,MMI برای سه ساختار اکسیدروی آلائیده شده با منگنز	۸۹
جدول ۱: اعداد کوانتومی نسبیتی	۱۰۶

فهرست شکل‌ها

صفحة

عنوان

۲۰	۱-۱ نمایش نواحی کرات مافین‌تین و نواحی بین کرات
۲۹	۱-۲ ساختار نواری نیمرسانا
۳۰	۲-۱ نمایش ساختار نواری رسانا، عایق، نیمرسانا
۳۲.....	۳-۱ فرآیند آلانیدن
۳۳	۴-۱ ناخالصی نوع n
۳۴	۵-۱ ترازهای الکترون طرد شده در باند ممنوع
۳۵	۶-۱ ناخالصی نوع p
۳۹	۷-۱ نوار رسانش، نوار ظرفیت و نوار ممنوعه (گاف نواری) را در رسانا، نارسانا و نیمه‌رسانا...
۴۰	۸-۱ گاف نواری نیمرسانا
۴۱	۹-۱ الف) گاف نواری مستقیم ب) گاف نواری غیرمستقیم
۴۲	۱۰-۱ نمایش الکترونها و حفره‌ها
۴۲	۱۱-۱ الف: نمایش گاف نواری
۴۳	۱۱-۲ ب: حرکت الکترون از باند ظرفیت به باند رسانش
۴۳	۱۲-۱ تأثیر میدان الکتریکی بر الکترون‌ها

۴۴	۱۳-۲ ایجاد جریان الکتریکی
۴۵	۱۴-۲ مدل الکترون آزاد از فلز
۴۶	۱۵-۲ نمودار ساده باند انرژی مورد استفاده برای توصیف نیمرسانها
۵۰	۱۶-۲ جدول تناوبی عناصر
۵۱	۱۷-۲ رفتار پارامغناطیسی موادر حضور میدان مغناطیسی(سمت راست)، در غیاب میدان مغناطیسی(سمت چپ)
۵۳	۱۸-۲ حوزه‌های مغناطیسی در یک ماده فرومغناطیس
۵۴	۱۹-۲ فرومغناطیس در حضور میدان مغناطیسی(سمت راست)، در غیاب میدان مغناطیسی(سمت چپ)
۵۶	۲۰-۲ ساختار پادفرومغناطیس
۵۶	۲۱-۲ ساختارفری مغناطیس
۶۱	۲۳-۱ نمایش نیمرسانای غیرمغناطیسی(شکل سمت چپ)، نیمرسانای مغناطیسی رقیق شده(شکل سمت راست)
۶۲	۲-۳ ساختار Wurtzite اکسیدروی
۶۳	۳-۳ تعداد نزدیکترین همسایگان هر اتم ساختار Wurtzite
۶۴	۴-۳ ساختار Zinc blende اکسیدروی
۶۴	۵-۳ تعداد نزدیکترین همسایگان ساختار Zinc blende
۶۵	۶-۳ ساختار نمک طعام Rock salt اکسیدروی

۶۵	۷-۳ نمایش نزدیکترین همسایگان برای هر اتم از ساختار Rock salt
۷۴	۸-۳ ساختار نواری اکسیدروی کپهای
۷۶	۹-۳ ابرسلول اکسیدروی با آلائیدن یک اتم منگنز
۷۶	۱۰-۳ ساختار نواری ترکیب $Zn_{۹۳/۷۵} Mn_{۶/۲۵} O$
۷۷	۱۱-۳ هیبریداسیون‌های مختلف اوربیتال d
۷۹	۱۲-۳ ابرسلول اکسیدروی با آلائیدن دو اتم منگنز
۸۰	۱۳-۳ ساختار ابرسلول اکسیدروی با آلائیدن سه اتم منگنز
۹۵	۱ صفحه نمایش (sission)
۹۶	۲ صفحه نمایش ایجاد (Struct Generation)
۹۹	۳ صفحه نمایش (Initialization)
۱۰۲	۴ نمایش اعداد مربوط به انرژی‌های اوربیتالی اتم Zn در خروجی lstart
۱۰۲	۵ نمایش اعداد مربوط به انرژی‌های اوربیتالی اتم O در خروجی lstart
۱۰۴	۶ نمایشی از فایل case.inst برای ساختار Zno
۱۰۶	۷ نمایش فایل case.in1st
۱۰۸	۸ نمایش فایل case.in2
۱۰۸	۹ نمایش فایل case.inm
۱۱۲	۱۰ صفحه نمایش اثر optimize

۱۱۳	۱۱ نمایش مرحله Optimize Job
۱۱۴	۱۲ صفحه نمایش رسم چگالی حالات
۱۱۵	۱۳ نمایش فایل case.int
۱۱۷	۱۴ صفحه نمایش Band structure
۱۱۸	۱۵ نمایش فایل case.insp

فهرست نمودار

صفحه	عنوان
۶۷.....	۳-۱ تغییرات انرژی (ev) بر حسب RKmax
۶۹.....	۳-۲ تغییرات انرژی(ev) برحسب Kpoint
۷۱.....	۳-۳ تغییرات انرژی برحسب حجم برای ساختار Wurtzite اکسیدروی
۷۱.....	۳-۴ تغییرات انرژی بر حسب Zinc blende حجم برای ساختار اکسیدروی
۷۲.....	۳-۵ تغییرات انرژی بر حسب Rock salt حجم برای ساختار اکسیدروی
۷۴.....	۳-۶ چگالی حالت الکترونی ساختار ZnO
۷۵.....	۳-۷ چگالی حالت های اوربیتال های Zn ۳d و O ۲p
۷۸.....	۳-۸ چگالی حالت های الکترونی dos بر حسب انرژی ترکیب Zn _{۹۳/۷۵} Mn _{۶/۲۵} O
۷۸.....	۳-۹ چگالی حالت های الکترونی d و O ترکیب dxz+dyz
۷۹.....	۳-۱۰ چگالی حالت های الکترونی dos بر حسب انرژی ترکیب Zn _{۸۷/۵} Mn _{۱۲/۵} O
۸۰.....	۳-۱۱ چگالی حالت های الکترونی d و O ترکیب dxy
۸۱.....	۳-۱۲ چگالی حالت های الکترونی dos بر حسب انرژی ترکیب Zn _{۸۱/۲۵} Mn _{۱۸/۷۵} O
۸۱.....	۳-۱۳ چگالی حالت های الکترونی d و O ترکیب dxz
۸۳.....	۳-۱۴ چگالی حالت الکترونی dos بر حسب انرژی برای لایه نازک اکسیدروی فاز Wz
۸۴.....	۳-۱۵ چگالی حالت الکترونی ساختار Wz ترکیب ZnO-Mn

- ۱۶-۳ نمودار چگالی حالت الکترونی d و dx^2-y^2 - y^2 ترکیب لایه نازک ZnO-Mn ۸۵.....
- ۱۷-۳ چگالی حالت الکترونی dos بر حسب انرژی برای لایه نازک اکسیدروی فاز Zb ۸۵.....
- ۱۸-۳ چگالی حالت الکترونی لایه نازک ترکیب ZnO-Mn ۸۶.....
- ۱۹-۳ چگالی حالت الکترونی d و deg ترکیب ZnO-Mn ۸۷.....
- ۲۰-۳ چگالی حالت الکترونی لایه نازک فاز Rs ۸۷.....
- ۲۱-۳ چگالی حالت‌های الکترونی لایه نازک ترکیب ZnO-Mn ۸۸.....
- ۲۲-۳ چگالی حالت الکترونی d و deg ترکیب ZnO-Mn ۸۸.....

تقدیم به پدر و مادرم

سایه‌بانان آرامش

اسوه‌های فداکاری و محبت

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.

تقدیم به:

دو برادر عزیزم، که با مهربانی و عطوفت‌های بیکرانشان و با اشتیاق نگاهشان در سراسر زندگانیم خاطرم را آرام و عزمم را طولانی کردند.

سپاسگزاری

در آغاز از خانواده عزیزم که در تمام مراحل زندگی همراه و پشتیبان من بودند
صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

اگر محقق را داشتجوئی بدانیم که در اقیانوس علم در جستجوی گوهر یا
گوهرهای گرانبهاست، استاد را باید کسی دانست که در این اقیانوس گاهی آرام و
گاهی پرتلاطم نقش ارزنده راهنمائی غواص جویای گوهر را ایفا می‌کند. از استاد
راهنمای بزرگوارم، جناب آقای دکتر بابائی‌پور که در مراحل مختلف تحقیق یاریم
نمودند شکر و قدردانی می‌کنم. از استاد مشاور گرامیم جناب آقای دکتر سموات
تشکر می‌کنم.

در پایان بر خود واجب می‌دانم که از زحمات بیدریغ آقایان: جعفر جلیلیان،
مسعود شاهرخی، احمد عبدالملکی تشکر و قدردانی نمایم.

فصل اول: نظریه قابعی

چگالی



یکی از اهداف مهم در فیزیک ماده چگال بررسی خواص الکترونی و ساختاری مواد است. در مقیاس میکروسکوپی می‌توان هر ماده‌ای را یک دستگاه بس ذره‌ای دانست. هر دستگاه بس ذره‌ای شامل تعداد بسیار زیادی ذرات مشابه یا غیر مشابه است که با هم‌دیگر برهمنکش می‌کنند.

۱-۱) روش‌های محاسبه انرژی بلور:

در بررسی نظری دستگاه‌های بس ذره‌ای دو روش در نظر گرفته شده:

- ۱) روش کلاسیکی
- ۲) روش کوانتمومی

۱) در روش کلاسیکی بین اتم‌ها یا یون‌ها یک پتانسیل فرضی در نظر گرفته می‌شود. در اینجا حرفی از الکترون نمی‌زنند اثر الکترون را بطور غیر مستقیم در پتانسیل فرضی لحاظ می‌کنند. پس مبنای محاسبات، انتخاب پتانسیل فرضی است و نیروی وارد بر هر اتم و انرژی بلور با مشتق‌گیری از این پتانسیل محاسبه می‌شود. در این روش آثاری که فقط منشأ کوانتمومی دارند مثل برهمنکش تبادلی را نمی‌توان لحاظ کرد و با توجه به اینکه پتانسیل واحد نیست و از ماده‌ای به ماده دیگر تغییر می‌کند این روش مشکلاتی را به وجود می‌آورد. از مزایای این روش سرعت بالای محاسبات است.

۲) در این روش فقط اصول کوانتمومی و محاسبات طولانی بهره می‌گیرند برای سیستم بس ذره‌ای تعداد زیادی توابع موج در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین محاسبات با زمان بالائی و دقت پائین انجام می‌گیرند. با استفاده از قوانین الکترومغناطیس، برهمنکش‌های الکترونها و هسته‌ها با یکدیگر را مشخص کرده و با تقسیم هامیلتونی مستقل از زمان به دو بخش الکترونی و یونی، ویژه توابع و ویژه مقادیر دستگاه محاسبه می‌شود. در این روش خواصی از بلور نظیر ساختار نواری انرژی، چگونگی پیوند بین اتمها، که به رفتار الکترونها مربوط است همچنین گرادیان میدان الکتریکی و مغناطیسی فوق‌ریز اطراف هسته و ... با این روش محاسبه می‌شود. روش کوانتمومی به دو صورت قابل استفاده است: